



HA

0330
2600 #3
2614

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT: TSUTOMU YAMADA)
SERIAL NO.: 09/679,097) Group Art Unit:
FILED: October 4, 2000) Examiner:
FOR: COLOR DISPLAY DEVICE)

CLAIM FOR PRIORITY

RECEIVED

DEC 1 1 2000

Technology Center 2600

The Assistant Commissioner for
Patents and Trademarks
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of the Japanese Patent Application No. Hei 11-283181 filed on October 4, 1999. The enclosed Application is directed to the invention disclosed and claimed in the above-identified application.

Applicant's hereby claim the benefit of the filing date of October 4, 1999 of the Japanese Patent Application No. Hei 11-283181, under provisions of 35 U.S.C. 119 and the International Convention for the protection of Industrial Property.

Respectfully submitted,

TSUTOMU YAMADA

CANTOR COLBURN LLP
Applicant's Attorneys

By:

Juan C. Villar
Registration No. 34,271
Customer No. 23413

I HEREBY CERTIFY THAT THIS CORRESPONDENCE
IS BEING DEPOSITED WITH THE UNITED STATES
POSTAL SERVICE AS FIRST CLASS MAIL IN AN
ENVELOPE ADDRESSED TO:
ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D. C. 20231

ON November 16, 2000

DATE OF DEPOSIT

Jennifer Matson

(TYPED OR PRINTED NAME OF PERSON MAILING PAPER OR FEE)

Jennifer Matson 11/16/00

SIGNATURE

DATE

Date: November 16, 2000



Translation of Priority Certificate

RECEIVED

DEC 11 2000

Technology Center 2600

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: October 4, 1999

Application Number: Patent Application
No. Hei 11-283181

Applicant(s): SANYO ELECTRIC CO., LTD.

September 29, 2000

Commissioner, Kozo OIKAWA
Patent Office

Priority Certificate No. 2000-3078818



日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年10月 4日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第283181号

出 願 人

Applicant (s):

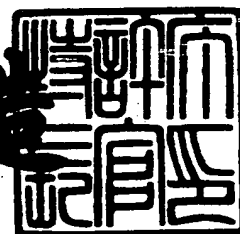
三洋電機株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2000年 9月29日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3078818

【書類名】 特許願

【整理番号】 KHB0991084

【提出日】 平成11年10月 4日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/02

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三洋電機株式会
社内

 【氏名】 山田 努

【特許出願人】

 【識別番号】 000001889

 【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

 【代表者】 近藤 定男

【代理人】

 【識別番号】 100109368

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 稲村 悦男

 【連絡先】 電話 0 3 - 3 8 3 7 - 7 7 5 1 法務・知的財産部 東
京事務所

【選任した代理人】

 【識別番号】 100111383

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 芝野 正雅

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 013033

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904451

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書
 【発明の名称】 カラー表示装置
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 各表示画素に、自発光素子と、該自発光素子に接続され電流を供給する駆動用薄膜トランジスタとを備えたカラー表示装置において、いずれかの色の表示画素と他の色の表示画素で前記駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが異なっていることを特徴とするカラー表示装置。

【請求項 2】 各表示画素に、自発光素子と、該自発光素子に電流を供給するタイミングを制御するスイッチング用薄膜トランジスタと、前記自発光素子に接続され電流を供給する駆動用薄膜トランジスタとを備えたカラー表示装置において、いずれかの色の表示画素と他の色の表示画素で前記駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが異なっていることを特徴とするカラー表示装置。

【請求項 3】 前記トランジスタサイズは前記自発光素子の発光効率に応じて設定されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のカラー表示装置。

【請求項 4】 発光効率が高い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、発光効率が低い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも小さくしたことを特徴とする請求項 3 に記載のカラー表示装置。

【請求項 5】 最も発光効率が高い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、他の発光効率の自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも小さくしたことを特徴とする請求項 3 に記載のカラー表示装置。

【請求項 6】 前記最も発光効率が高い自発光素子は緑色であることを特徴とする請求項 5 に記載のカラー表示装置。

【請求項 7】 最も発光効率が低い自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、他の発光効率の自発光素子に接続された駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも大きくしたことを特徴とする請求項 3 に記載のカラー表示装置。

【請求項 8】 前記最も発光効率が低い自発光素子は赤色又は青色であるこ

とを特徴とする請求項 7 に記載のカラー表示装置。

【請求項 9】 発光効率が低くなるにつれて前記自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが順に大きくなることを特徴とする請求項 3 に記載のカラー表示装置。

【請求項 1 0】 前記自発光素子はエレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項 1 乃至 9 のうちいずれか 1 項に記載のカラー表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、自発光素子、例えばエレクトロルミネッセンス (Electro Luminescence: 以下、「E L」と称する。) 素子と、薄膜トランジスタ (Thin Film Transistor: 以下、「T F T」と称する。) を備えた表示装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、自発光素子である E L 素子を用いた E L 表示装置が、C R T や L C D に代わる表示装置として注目されている。

【0 0 0 3】

また、その E L 素子を駆動させるスイッチング素子として T F T を備えた表示装置も研究開発されている。

【0 0 0 4】

図 2 に有機 E L 表示装置の等価回路図を示し、図 3 に有機 E L 表示装置の表示画素付近を示す平面図を示し、図 4 (a) に図 3 中の A - A 線に沿った断面図を示し、図 4 (b) に図 3 中の B - B 線に沿った断面図を示す。また、図 5 には、有機 E L 表示装置の表示画素配列を示す。

【0 0 0 5】

図 2 及び図 3 に示すように、ゲート信号線 5 1 とドレイン信号線 5 2 とに囲まれた領域に表示画素 1 1 0 が形成されており、マトリクス状に配置されている。また、両信号線 5 1, 5 2 の交点付近にはスイッチング用 T F T である第 1 の T F T 3 0 が備えられており、その T F T 3 0 のソース 1 3 s は後述の保持容量電

極線 5 4 との間で容量をなす容量電極 5 5 を兼ねるとともに、E L 素子駆動用 T F T である第 2 の T F T 4 0 のゲート 4 1 に接続されている。第 2 の T F T のソース 4 3 s は有機 E L 素子 6 0 の陽極 6 1 に接続され、他方のドレイン 4 3 d は有機 E L 素子 6 0 に供給される電流源である駆動電源線 5 3 に接続されている。

【 0 0 0 6 】

また、ゲート信号線 5 1 と並行に保持容量電極線 5 4 が配置されている。この保持容量電極線 5 4 はクロム等から成っており、ゲート絶縁膜 1 2 を介して T F T のソース 1 3 s と接続された容量電極 5 5 との間で電荷を蓄積して容量を成している。この保持容量 5 6 は、第 2 の T F T 4 0 のゲート電極 4 1 に印加される電圧を保持するために設けられている。

【 0 0 0 7 】

図 4 に示すように、有機 E L 表示装置は、ガラスや合成樹脂などから成る基板又は導電性を有する基板あるいは半導体基板等の基板 1 0 上に、T F T 及び有機 E L 素子を順に積層形成して成る。ただし、基板 1 0 として導電性を有する基板及び半導体基板を用いる場合には、これらの基板 1 0 上に SiO_2 や SiN などの絶縁膜を形成した上に第 1、第 2 の T F T 及び有機 E L 表示素子を形成する。

【 0 0 0 8 】

まず、スイッチング用の T F T である第 1 の T F T 3 0 について説明する。

【 0 0 0 9 】

図 4 (a) に示すように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板 1 0 上に、半導体膜 (p - Si 膜) からなる能動層 1 3、その上にゲート絶縁膜 1 2、及びクロム (Cr)、モリブデン (Mo) などの高融点金属からなるゲート電極 1 1 を兼ねたゲート信号線 5 1 が順に積層されている。また A l から成るドレイン信号線 5 2 を備えており、有機 E L 素子の駆動電源であり A l から成る駆動電源線 5 3 が配置されている。

【 0 0 1 0 】

そして、ゲート電極 1 1、ゲート絶縁膜 1 2 上の全面には、 SiO_2 膜、 SiN 膜及び SiO_2 膜の順に積層された層間絶縁膜 1 5 が形成されており、ドレイン 1 3 d に対応して設けたコンタクトホールに A l 等の金属を充填したドレイン

電極 1 6 が設けられ、更に全面に有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜 1 7 が形成されている。

【 0 0 1 1 】

次に、有機 E L 素子の駆動用の T F T である第 2 の T F T 4 0 について説明する。

【 0 0 1 2 】

図 4 (b) に示すように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板 1 0 上に、半導体膜 (p - S i 膜) からなる能動層 4 3 、ゲート絶縁膜 1 2 、及び C r 、 M o などの高融点金属からなるゲート電極 4 1 が順に形成されており、その能動層 4 3 には、チャンネル 4 3 c と、このチャンネル 4 3 c の両側にソース 4 3 s 及びドレイン 4 3 d が設けられている。そして、ゲート絶縁膜 1 2 及び能動層 4 3 上の全面に、 S i O ₂ 膜、 S i N 膜及び S i O ₂ 膜の順に積層された層間絶縁膜 1 5 を形成し、ドレイン 4 3 d に対応して設けたコンタクトホールに A l 等の金属を充填して駆動電源に接続された駆動電源線 5 3 が配置されている。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜 1 7 を備えている。そして、その平坦化絶縁膜 1 7 のソース 4 3 s に対応した位置にコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを介してソース 4 3 s とコンタクトした I T O (Indium Thin Oxide) から成る透明電極、即ち有機 E L 素子の陽極 6 1 を平坦化絶縁膜 1 7 上に設けている。

【 0 0 1 3 】

有機 E L 素子 6 0 は、 I T O 等の透明電極から成る陽極 6 1 、 M T D A T A (4,4-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl) などから成る第 1 ホール輸送層、及び T P D (4,4,4-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine) などからなる第 2 ホール輸送層のホール輸送層 6 3 、キナクリドン (Quinacridone) 誘導体を含む B e b q 2 (10-ベンゾ [h] キノリノールーベリリウム錯体) などから成る発光層 6 4 及び B e b q 2 などから成る電子輸送層からなる発光素子層 6 5 、マグネシウム (M g) と A g (銀) の合金、あるいはフッ化リチウム (L i F) と A l の積層体などから成る陰極 6 6 がこの順番で積層形成された構造である。その発光素子層 6 5 の発光材料を所定の色を発光する材料を選択すること

により、それぞれの色を発光する表示画素が構成され、図 5 に示すように、各色の表示画素をマトリクス状に配置することで有機 E L 表示装置が構成されている。

【 0 0 1 4 】

また有機 E L 素子は、陽極から注入されたホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁基板を介して外部へ放出されて発光する。

【 0 0 1 5 】

【発明が解決しようとする課題】

このように、各色を発光する各表示画素には、その表示画素 1 1 0 ごとに接続された有機 E L 素子を駆動するための E L 素子駆動用 T F T が接続されているが、これらの T F T はいずれのトランジスタサイズ、即ち T F T の半導体膜とゲート電極とが重畳した領域のチャネルのチャネル幅 W とチャネル長 L (図 3 の場合には、 $L = L_1 + L_2$) との比 W/L は均一な T F T である。

【 0 0 1 6 】

また、各色を発光する各表示画素の発光層の発光効率、その発光層を構成する有機発光材料によって各色ごとに異なっている。

【 0 0 1 7 】

従って、各色のその発光効率に応じて、異なる電流値を各色の有機 E L 素子に供給し、他の色と同じレベルの輝度を得て各色のホワイトバランスをとるためには、駆動電源の電流値を各色ごとに異ならせるか、あるいは各表示画素に接続された第 1 の T F T に供給するドレイン信号の電位を各色に応じて変える必要がある。即ち、発光効率の低い色の発光層を有する有機 E L 素子には、発光効率の高い色の発光層を有する有機 E L 素子に比べて多くの電流を流さなければならなかった。

【 0 0 1 8 】

しかしながら、駆動電源の電流値を各表示画素の色ごとに異ならせるためには駆動電源線を各表示画素を配置した領域内を複雑に配置しなければならず、また

、第 1 の T F T に供給するドレイン信号の電位を各色に応じて変えるためには、第 1 の T F T に信号を供給する回路構成が複雑になってしまうという欠点があった。

【 0 0 1 9 】

そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑みて為されたものであり、E L 素子を備えた各色の表示画素の E L 素子駆動用 T F T のサイズを発光効率に応じて異ならせることにより、各色の表示画素のホワイトバランスを回路構成を複雑にすることなくかつ容易に制御することができる E L 表示装置を提供することを目的とする。

【 0 0 2 0 】

【課題を解決するための手段】

本発明の表示装置は、各表示画素に、自発光素子と、該自発光素子に接続され電流を供給する自発光素子駆動用薄膜トランジスタとを備えたカラー表示装置において、各色の表示画素のうちいずれかの色の表示画素の前記自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが異なっているものである。

【 0 0 2 1 】

また、上述の表示装置は、前記トランジスタサイズは前記自発光素子の発光効率に応じて設定されている表示装置である。

【 0 0 2 2 】

更に、発光効率が高い自発光素子に接続された自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、該自発光素子の発光効率よりも低い発光効率の自発光素子に接続された自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも小さくした表示装置である。

【 0 0 2 3 】

また、最も発光効率が高い自発光素子に接続された自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、他の発光効率の自発光素子に接続された自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも小さくした表示装置である。

【 0 0 2 4 】

更にまた、前記最も発光効率が高い自発光素子は緑色である表示装置である。

【0025】

また、最も発光効率が低い自発光素子に接続された自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズを、他の発光効率の自発光素子に接続された自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズよりも大きくした表示装置である。

【0026】

また、前記最も発光効率が低い自発光素子は赤色又は青色である表示装置である。

【0027】

また、発光効率が低くなるにつれて前記自発光素子駆動用薄膜トランジスタのトランジスタサイズが順に大きくなる表示装置である。

【0028】

また、前記自発光素子はエレクトロルミネッセンス素子である表示装置である。

【0029】

【発明の実施の形態】

本発明の表示装置について以下に説明する。

【0030】

図1は、本発明の表示装置をEL表示装置100に応用した場合を示し、EL素子に電流を供給するEL素子駆動用TFTの一部を拡大した平面図である。

【0031】

なお、同図には各表示画素が、赤色(110R)、緑色(110G)及び青色(110B)を発光する場合であって、前述の図3に示す表示画素のうち、表示画素に配置された駆動用TFTのチャネル43c、ソース43s及びドレイン43dを備えた能動層と、ゲートとのみを拡大して示している。

【0032】

同図に示すように、EL表示装置100には、複数のゲート信号線51が同図の左右方向に、また複数のドレイン信号線53が同図の上下方向に配置されてお

り、それらの信号線 51, 53 は互いに交差している。

【0033】

それらの交点付近には、図 3 に示したように、両信号線 51, 53 に接続され EL 素子 60 に電流を供給するタイミングを制御するスイッチング用 TFT 30 と、その TFT 30 のソース 13s にゲートが接続され有機 EL 素子 60 に電流を供給しその有機 EL 素子 60 を駆動する EL 素子駆動用 TFT 40 と、その EL 素子駆動用 TFT 40 のソース 43s に陽極 61 が接続された有機 EL 素子 60 が形成されており、また、図 1 に示すように、各色の表示画素 110R, 110B, 110G はマトリックス状に配列されている。有機 EL 素子 60 の構造は従来の技術の欄で説明したものと同一であるので説明は省略する。

【0034】

ここで、各表示画素 110R, 110B, 110G に接続された EL 素子駆動用 TFT のトランジスタサイズ W/L について説明する。

【0035】

なお、本発明においては、TFT のトランジスタサイズとは、TFT のチャネルのチャネル幅 W とチャネル長 L との比、即ち W/L のことをいうものとする。

【0036】

本実施の形態においては、緑色の表示画素に配置する発光材料が最も発光効率が高く、赤色の表示画素に配置する発光材料の発光効率が次に高く、青色の表示画素に配置する発光材料の発光効率が最も低い場合である。即ち、緑色の発光効率 G_{eff} と、赤色の発光効率 R_{eff} と、青色の発光効率 B_{eff} の比が、 $G_{eff} : R_{eff} : B_{eff} = 10 : 3.8 : 1.8$ の場合について説明する。

【0037】

図 1 において EL 素子駆動用 TFT のトランジスタサイズ W/L の L は、 $L_1 + L_2$ である。

【0038】

緑色の表示画素の発光素子層の発光材料の発光効率が最も高いので、各表示画素の駆動用 TFT のトランジスタサイズ (W/L) のうち、緑色表示画素 110G の W/L を最も小さくして TFT が形成されている。

【0039】

他の色の表示画素 110R, 110B の W/L は、緑色の表示画素の 110G の W/L よりも大きく形成されている。

【0040】

具体的には、各色の発光効率の比が、 $G_{eff} : R_{eff} : B_{eff} = 10 : 3.8 : 1.8$ であるので、各 TFT のチャネル長 $L = 5 \mu m$ の一定とした場合は、緑色表示画素の TFT のチャネル幅 $W_G = 5 \mu m$ 、赤色表示画素の TFT のチャネル幅 $W_R = 13 \mu m$ 、青色表示画素のチャネル幅 $W_B = 28 \mu m$ とする。

【0041】

即ち、 $W_G : W_R : W_B = 1/G_{eff} : 1/R_{eff} : 1/B_{eff} = 1/10 : 1/3.8 : 1/1.8 = 1 : 2.6 : 5.6 = 5 : 13 : 28$ となる。

【0042】

このように、W/L を各色の発光効率に応じて設定することにより、EL 駆動電源の電流値を各色ごとに調整して供給する必要もなく、また、ドレイン信号線からのドレイン信号がスイッチング用 TFT 30 のソースから EL 駆動用 TFT 40 のゲートに供給される電圧を供給する際に、各色ごとに調整する必要もなくなる。それらの各電圧を調整することになると、駆動電源線が EL 表示装置の表示領域内を複雑に配置することになりそれによって断線や短絡発生の原因となるとともに、EL 素子駆動用の TFT のゲートに供給する電圧を制御するためにスイッチング用 TFT のドレインに供給する電圧を制御するための回路を別途設ける必要も無くなる。

【0043】

なお、図 1 においては、チャネル幅 W とチャネル長 L のうち、チャネル幅 W を一定にした場合を示しているが、本発明はそれに限定されるものではなく、チャネル長 L を一定として、チャネル幅 W を各色の表示画素で異ならせる。即ち、緑色表示画素のチャネル幅 W を最も小さくして、青色表示画素の TFT のチャネル幅 W を緑色表示画素の場合に比べ大きくし、更に赤色表示画素の TFT のチャネル幅 W を大きくする。

【0044】

このように、各色の表示画素に接続された E L 駆動用 T F T の W / L をその表示画素に配置された発光素子層の発光材料の発光効率に応じて異ならせることにより、駆動電源からの電圧を各色ごとに異ならせそれによって駆動電源線が複雑に E L 表示装置の表示領域内を配置することが無くなるとともに、スイッチング用 T F T 3 0 に供給されるドレイン信号を各色ごとに異ならせそれによって回路構成が複雑に成ることを防止することができる。

【 0 0 4 5 】

また、本実施の形態においては、発光する各色を赤、緑、緑とした場合、発光効率の最も良い緑色の表示画素に接続された E L 駆動用 T F T のトランジスタサイズ W / L を最も小さく、次に発光効率の悪い赤色の表示画素に接続された E L 駆動用 T F T の W / L を大きくし、最も発光効率の悪い青色の表示画素に接続された E L 駆動用 T F T の W / L を最も大きくした場合を示したが、発光層の発光材料によっては、最も発光効率の良い色、例えば緑色と、次に発光効率の良い色、例えば赤色の表示画素とが同じ W / L であって、残りの色、例えば青色の表示画素の W / L だけが大きくても良く、また、発光効率が最も悪い青色と次に発光効率が良くない赤色の表示画素の W / L が同じであって、残りの発光効率の最も良い色、例えば緑色の表示画素の W / L が小さくても、本願特有の効果を奏することができる。

【 0 0 4 6 】

また、本実施の形態においては、赤色の表示画素 1 1 0 R と青色の表示画素 1 1 0 B の W / L を赤色の表示画素 1 1 0 R の W / L の方が大きい場合について説明したが、赤色の表示画素 1 1 0 R と青色の表示画素 1 1 0 B の W / L の大きさの順番は、それらの発光効率が材料によって異なるため、材料によって入れ替わることがある。表示画素の各色を R、G、B とした場合には、発光効率が最も高い G の表示画素 1 1 0 G に接続された T F T の W / L を最も小さくする。

【 0 0 4 7 】

また、表示のホワイトバランスをとる場合、材料の発光効率以外にも、各色の発光材料の色度に応じて各色の T F T に流れる電流値を調整するが、その色度に応じてトランジスタサイズを調整しても良い。

【0048】

また、本実施の形態においては、同じ色の表示画素が上下方向に並んだいわゆるストライプ配列の場合を示したが、本発明はそれに限定されるものではなく、いわゆるデルタ配列でも採用は可能であり同様の効果を得ることができる。

【0049】

また、各色の発光層の材料としては、青色発光層の場合には例えばOXD（オキサジアゾール）、AZM（アゾメチン-亜鉛錯体）などを用い、赤色発光層の場合には例えばZnPr（ポリフィリン-亜鉛錯体）などを用い、緑色発光層の場合には例えばBeBq2（10-ベンゾ[h]キノリノール-ベリリウム錯体）などを用いることができる。

【0050】

このように、有機EL表示装置の各色の表示画素が、発光層の発光効率が最も良い緑色の表示画素と、この緑色の表示画素の発光効率よりも低い発光効率である赤色の表示画素と、赤色の表示画素の発光効率よりも更に低い発光効率である青色の表示画素とから成っている場合においては、緑色の表示画素に接続されたEL素子駆動用TFTのW/Lが赤色の表示画素に接続されたEL素子駆動用TFTのW/Lより小さいかあるいは等しく且つ赤色の表示画素に接続されたEL素子駆動用TFTのW/Lが青色の表示画素に接続されたEL素子駆動用のTFTのW/Lよりも小さくすることにより、駆動電源からの電流値を各色の表示画素ごとに異ならせるための駆動電源配線を複雑に配置する必要がなくなり、また、スイッチング用TFTに供給するドレイン信号にバイアス電圧を各色の信号ごとに異ならせるための周辺の回路を複雑にすることなく、容易に各色の表示画素の発光材料の発光効率に応じて電流値を制御することができるとともに、それによって容易に各色のホワイトバランスをとることができる。

【0051】

また、各色の表示画素に接続されたTFTのW/Lを上述のようにすることにより、各色の輝度のバランスの制御が可能であることから、容易に良好なホワイトバランスのとれた表示を得ることができる。

【0052】

なお、本実施の形態においては、E L素子駆動用T F Tは、ゲート電極がゲート絶縁膜を介して能動層の上方に設けられたいわゆるトップゲート構造を備えた場合を説明したが、本発明はゲート電極がゲート絶縁膜を介して能動層の下方に設けられたいわゆるボトムゲート構造を備えた場合にも同様の効果を奏することができる。

【 0 0 5 3 】

また、本実施の形態においてはE L表示装置のうち数画素分を示して説明したが、本発明はVGA (6 4 0 X 4 8 0) 、 SVGA (8 0 0 X 6 0 0) 、 XGA (1 0 2 4 X 7 6 8) 、 SXGA (1 2 8 0 X 1 0 2 4) など、任意の表示画素数に適用可能である。

【 0 0 5 4 】

【発明の効果】

本発明の表示装置によれば、各色の表示画素のホワイトバランスを回路構成を複雑にすることなくかつ容易に制御することができるE L表示装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明のE L表示装置の各色の表示画素のT F Tの一部拡大平面図である。

【図 2】

本発明のE L表示装置の等価回路図である。

【図 3】

E L表示装置の表示画素付近を表す平面図である。

【図 4】

E L表示装置の断面図である。

【図 5】

E L表示装置の各色の表示画素の配列を示す平面図である。

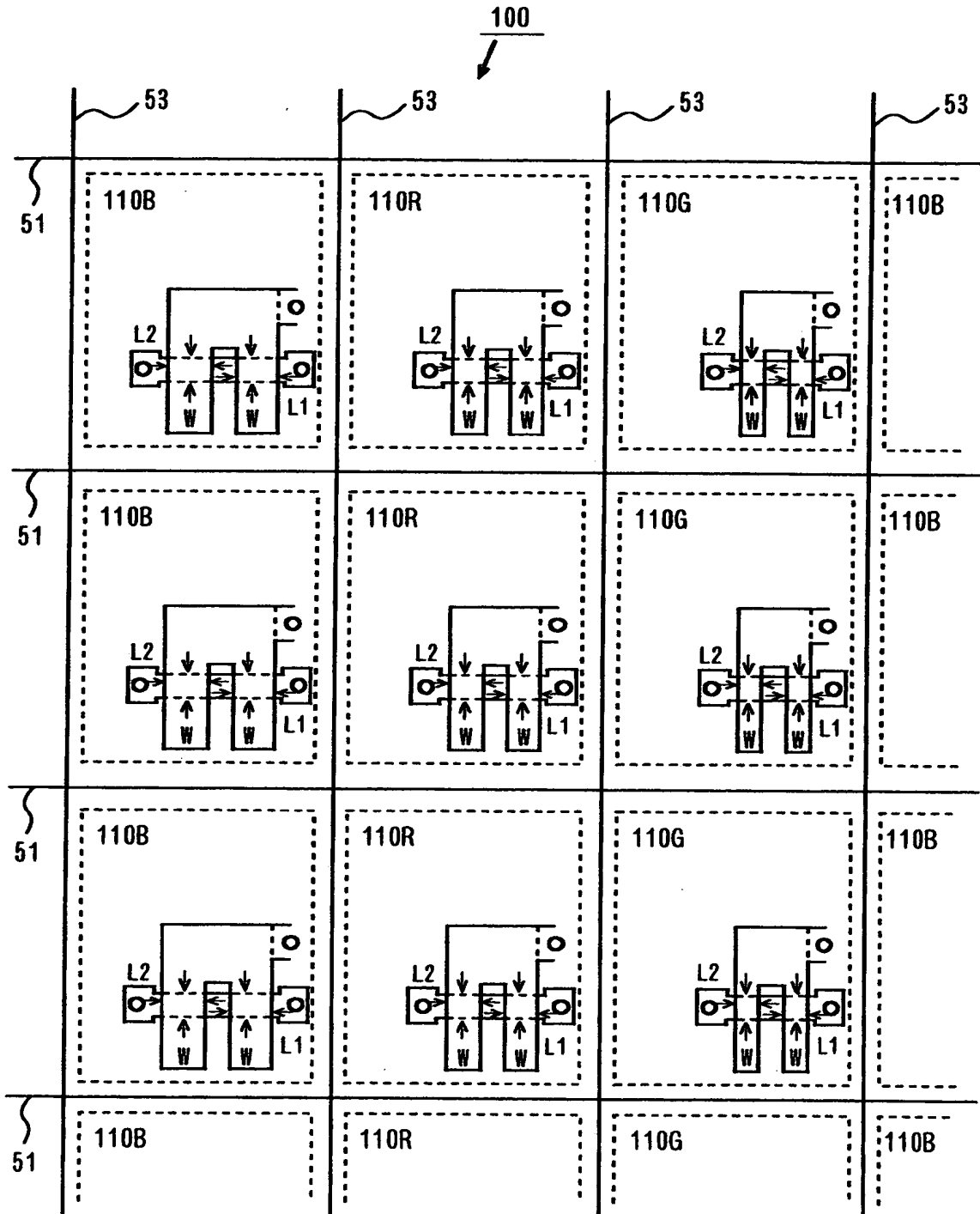
【符号の説明】

1 1 0 B	青色の表示画素
1 1 0 R	赤色の表示画素

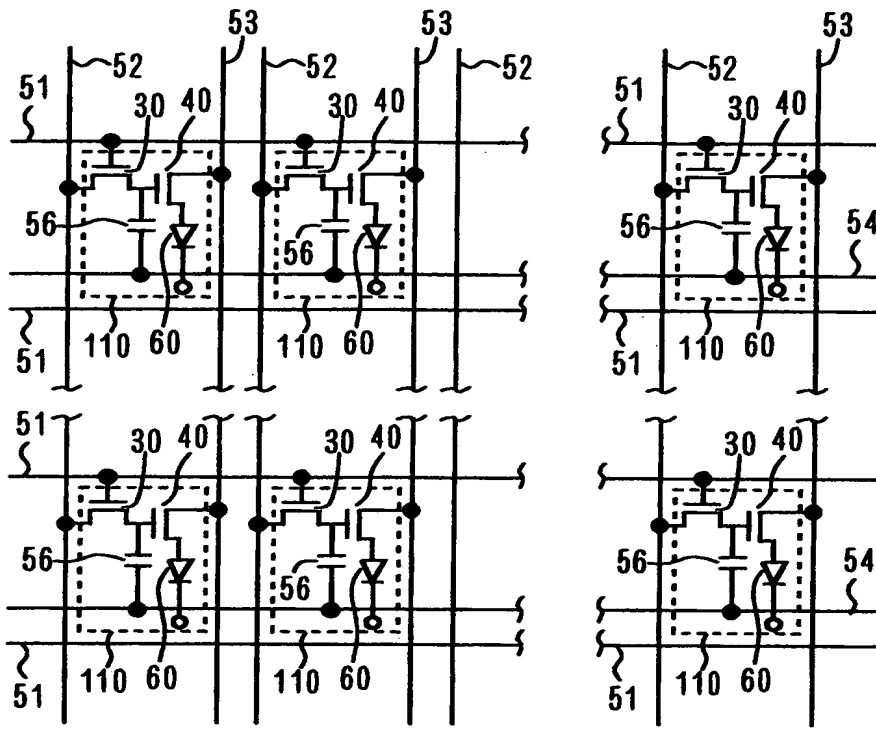
1 1 0 G	緑色の表示画素
3 0	第 1 の T F T
4 0	第 2 の T F T
5 1	ゲート信号線
5 2	ドレイン信号線
5 3	駆動電源線
5 4	保持容量電極線
1 0 0	E L 表示装置

【書類名】 図面

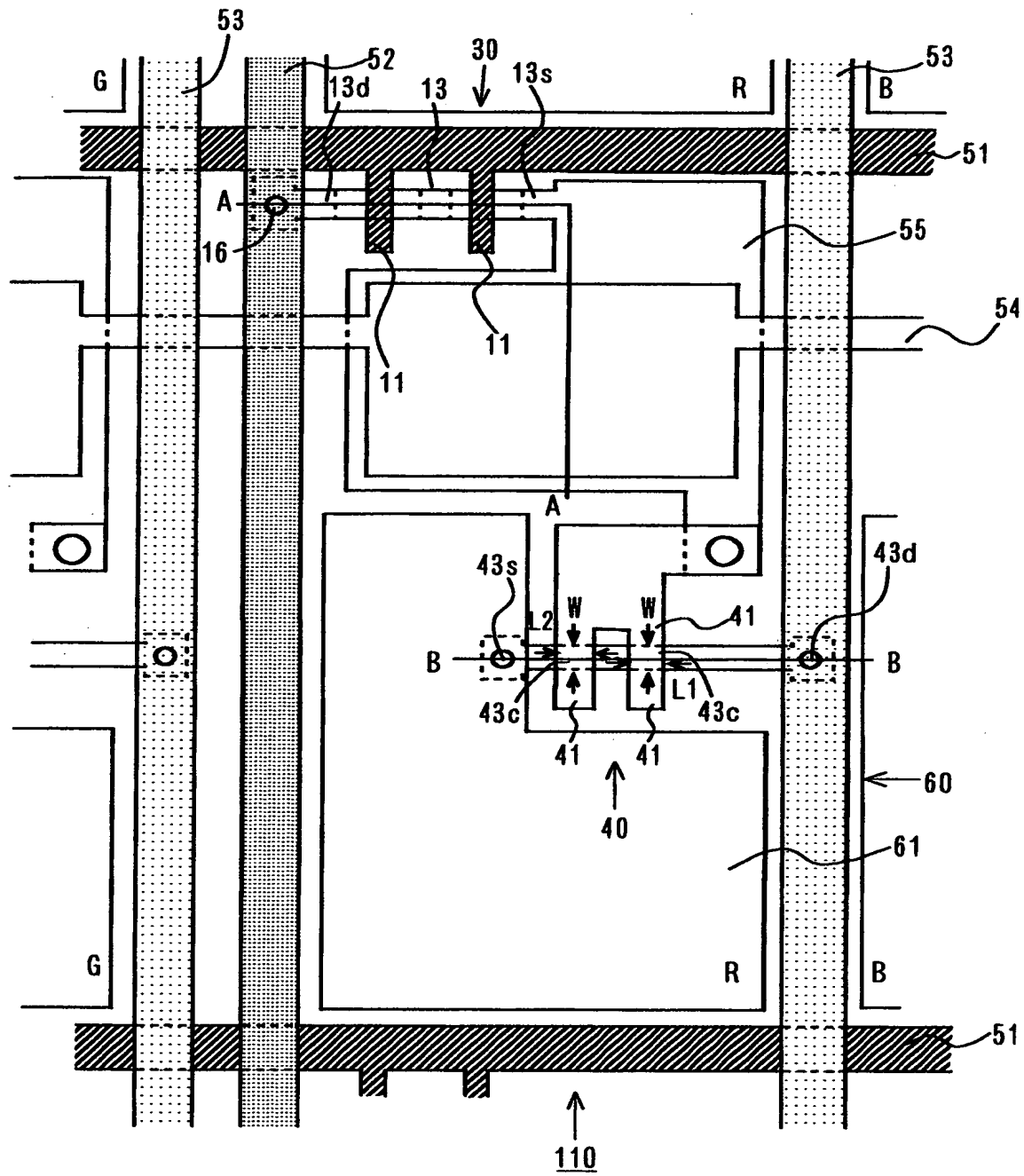
【図 1】



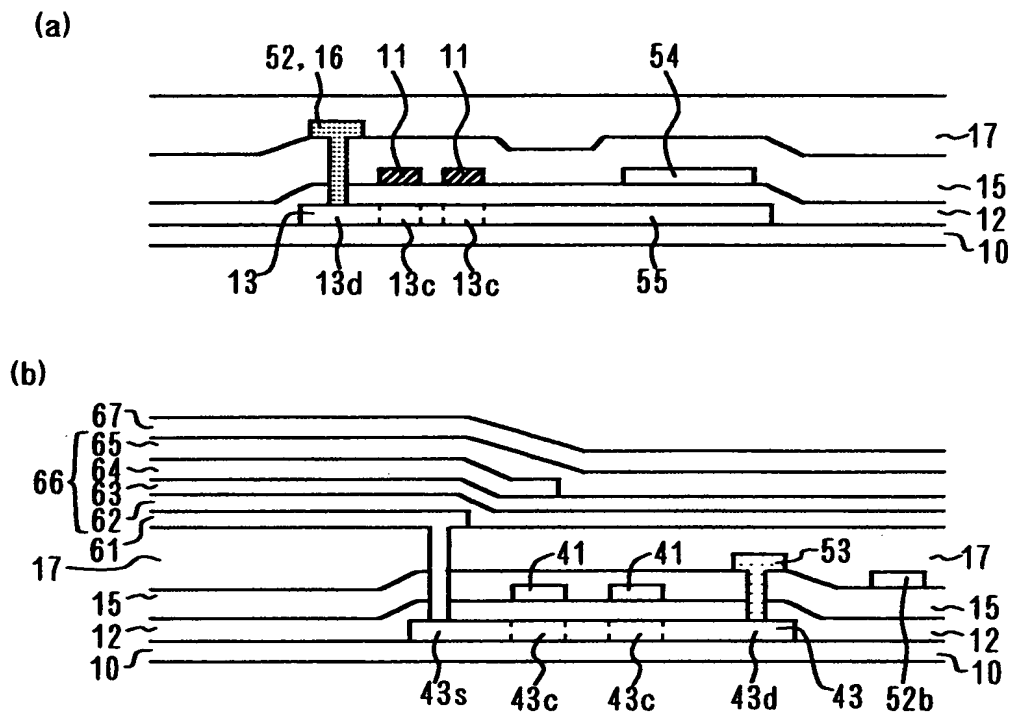
【図 2】



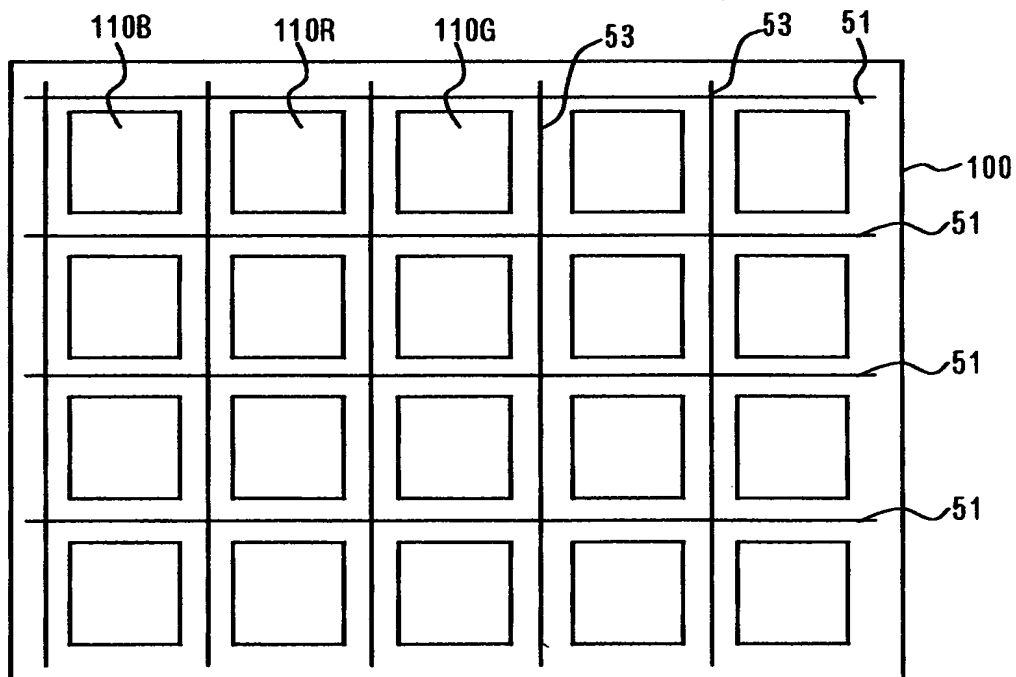
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 各色の表示画素のホワイトバランスを回路構成を複雑にすることなくかつ容易に制御することができる表示装置を提供する。

【解決手段】 陽極 6 1、発光層 6 3 及び陰極 6 6 を順に積層し各色を発光する E L 素子 6 0、及び個の E L 表示素子に電流を供給する E L 素子駆動用 T F T 4 0 を備えた表示画素 1 1 0 をマトリックス状に配列された表示装置であって、各色の表示画素 1 1 0 R、1 1 0 G、1 1 0 B に接続された E L 素子駆動用 T F T 4 0 のトランジスタサイズ (W/L) の大きさは、E L 素子の発光層 6 3 の発光効率が最もよい緑色の表示画素 1 1 0 G の T F T の場合が最も小さく、発光効率が低い赤色及び青色の表示画素の T F T の順に大きくなっている。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 8 8 9]

1. 変更年月日 1 9 9 3 年 1 0 月 2 0 日

[変更理由] 住所変更

住 所 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号

氏 名 三洋電機株式会社